

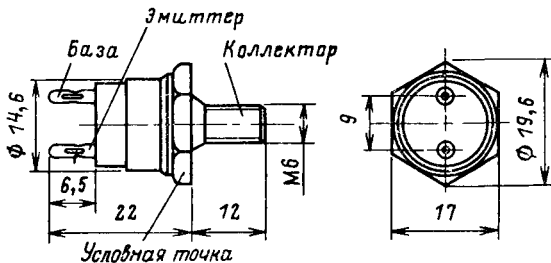
2Т917А

Транзистор кремниевый меза-планарный *п р н* универсальный высокочастотный мощный

Предназначен для работы в импульсных схемах, схемах усиления и генерирования

Выпускается в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе. Вывод эмиттера маркируется условной точкой на корпусе

Масса транзистора не более 20 г



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ А, $I_B = 2$ А не более	2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ А, $I_B = 2$ А не более	2,2 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 7$ А при $T = 298$ К	10–60

при $T = 213 \text{ К}$	8 -60
при $T = 398 \text{ К}$, $I_K = 2,5 \text{ А}$	10 -180
Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КЭ} = 10 \text{ В}$, $I_K = 1 \text{ А}$, $f = 30 \text{ МГц}$ не менее	2
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$, $U_{КЭ} = 150 \text{ В}$ не более	
при $T = 298 \text{ К}$ и $T = 213 \text{ К}$	20 мА
при $T = 398$, $U_{КЭ} = 120 \text{ В}$	40 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5 \text{ В}$ не более . . .	200 мА
Выходная мощность* при $U_K = 30 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$ в классе С	30-50 Вт
Коэффициент усиления по мощности* ($P_{\text{вых}} \leq 50 \text{ Вт}$) при $U_K = 30 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$	10-20
Коэффициент полезного действия при $U_K = 30 \text{ В}$, $f =$ $= 10 \text{ МГц}$ ($P_{\text{вых}} \leq 50 \text{ Вт}$)	70-80 %

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$	
при $T_{\text{н}} \leq 373 \text{ К}$	150 В
при $T_{\text{н}} = 423 \text{ К}$	75 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $\tau_{\text{н}} \leq 1 \text{ мс}$, $Q \geq 2$	200 В
Постоянное напряжение коллектор-база	150 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Импульсное напряжение база-эмиттер при $\tau_{\text{н}} \leq 1 \text{ мс}$, $Q \geq 2$, $I_{БЭ\text{н}} \leq 1 \text{ А}$	8 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_{\text{н}} \leq 1 \text{ мс}$, $Q \geq 2$. . .	15 А
Постоянный ток базы	5 А
Импульсный ток базы при $\tau_{\text{н}} \leq 1 \text{ мс}$, $Q \geq 2$	7 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K \leq$ $\leq 323 \text{ К}$	50 Вт
Мгновенная рассеиваемая мощность коллектора на фрон- тах в режиме переключения при длительности фрон- тов переходных процессов 0,1-0,2 мкс, $T_{\text{н}} \leq 423 \text{ К}$	500 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус	2 К/Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 213 до $T_K = 398 \text{ К}$

Примечания 1 Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, при $T_K > 323 \text{ К}$ определяется по формуле

$$P_{\text{Кмакс}} = (423 - T_K)/2$$

Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $T_{\text{н}} > 373 \text{ К}$ снижается линейно на 10% через каждые 10 К

2 Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм от корпуса транзистора